

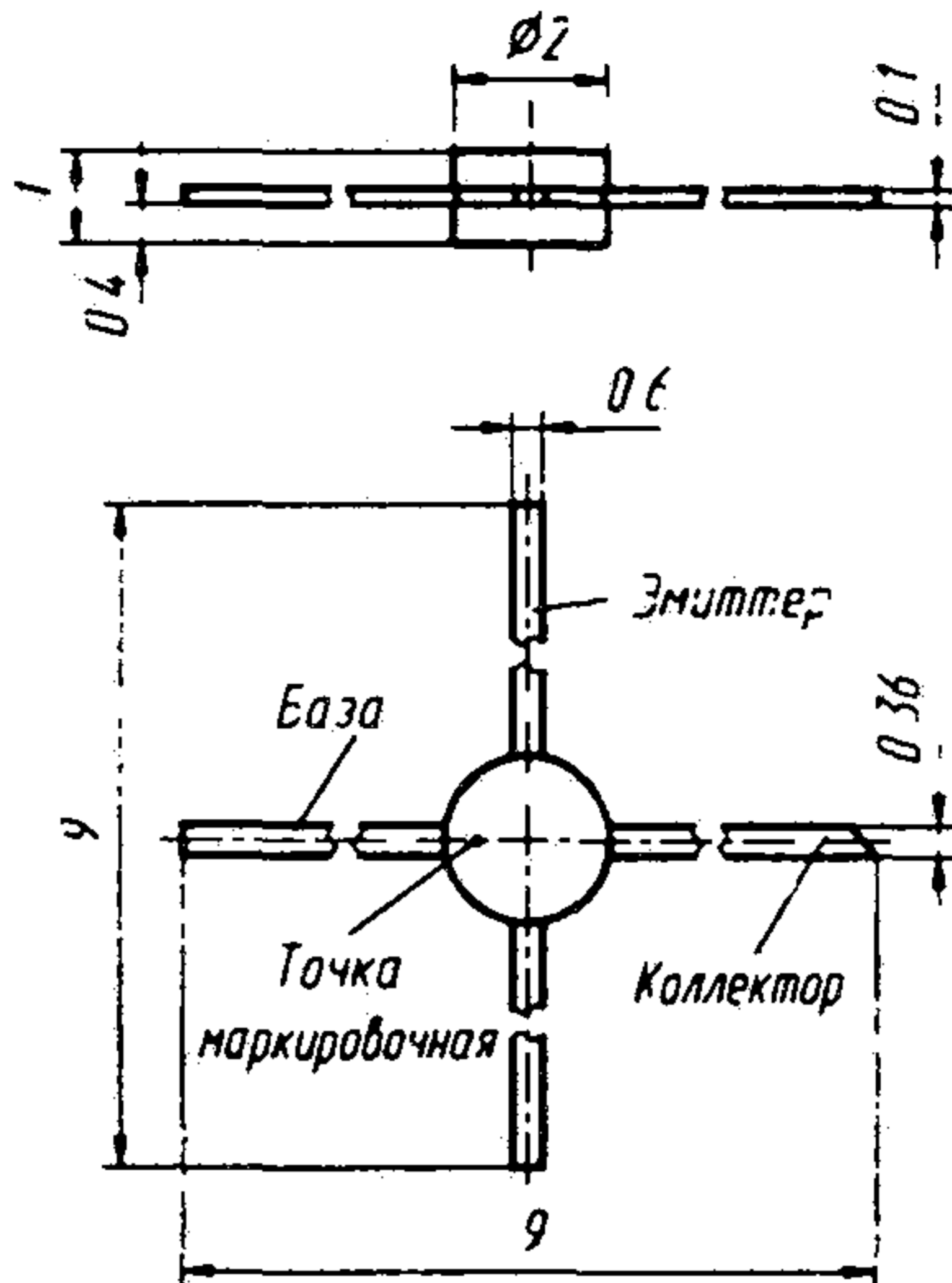
А641А, А641Б, А641В

Транзисторы кремниевые эпитаксиально-планарные структуры *n-p-n* усилительные с нормированным коэффициентом шума. Предназначены для применения в малошумящих усилителях на частотах 2...7,2 ГГц в составе гибридных интегральных микросхем, микросборок, обеспечивающих герметизацию и защиту транзисторов от воздействия влаги, соляного тумана, плесневых грибов, пониженного и повышенного давления и солнечной радиации. Бескорпусные на кристаллодержателе с гибкими выводами. Маркируются цветной точкой: А641А — красной, А641Б — желтой, А641В — черной. Тип прибора указывается в этикетке.

Масса транзистора не более 0,02 г.

Изготовитель — завод «Пульсар», г. Москва.

АБ41А-В1



Электрические параметры

Статический коэффициент передачи тока в схеме ОЭ при $U_{кб} = 7$ В, $I_3 = 5$ мА, не менее	15
Минимальный коэффициент шума при $U_{кб} = 7$ В, $I_3 = 5$ мА, не более:	
АБ41А на $f = 6$ ГГц	5 дБ
АБ41Б на $f = 5$ ГГц	5 дБ
АБ41В на $f = 4$ ГГц	3,6 дБ
Коэффициент усиления по мощности при $U_{кб} = 7$ В, $I_3 = 5$ мА, не менее:	
АБ41А на $f = 6$ ГГц	4 дБ
АБ41Б на $f = 5$ ГГц	5 дБ
АБ41В на $f = 4$ ГГц	6 дБ
Обратный ток коллектора при $U_{кб} = 100$ В, не более	0,5 мкА
Обратный ток эмиттера при $U_{эб} = 1$ В, не более	20 мкА

Предельные эксплуатационные данные

Постоянное напряжение коллектор—база	10 В
Постоянное напряжение коллектор—эмиттер при $R_{БЭ} = 1$ кОм	10 В
Постоянное напряжение эмиттер—база	1 В

Потенциал статического электричества	30 В
Постоянный ток коллектора	7 мА
Постоянная рассеиваемая мощность коллектора при $T = -60...+85$ °С	70 мВт
Температура окружающей среды	$-60...+125$ °С

При $T > +85$ °С максимально допустимая постоянная рассеиваемая мощность коллектора снижается линейно до 35 мВт при $+125$ °С.

Минимальное расстояние от кристаллодержателя до места пайки вывода 2 мм, температура пайки не выше $+265$ °С, время пайки не более 4 с. Допускается пайка выводов на расстоянии 1 мм от кристаллодержателя, температура пайки не более $+260$ °С, время пайки не более 3 с. При этом следует пользоваться серебряно-индиевыми и другими припоями, не приводящими к возникновению интерметаллических соединений. Допускается пайка выводов на расстоянии не менее 0,2 мм от кристаллодержателя при температуре пайки не выше $+160$ °С, время пайки не более 1 ч. Допускается использование только бескислотного флюса.

Допускается однократный изгиб выводов с радиусом закругления 1,5 мм на расстоянии 1 мм от кристаллодержателя. Допускается обрезать выводы на расстоянии не менее 1 мм от кристаллодержателя.

Материалы выводов: лента ДПРНТ 0,1 на НП2 по ГОСТ 2170-73, покрытие Н1, ЗлЗ.

При эксплуатации транзисторов в усилительных схемах следует учитывать возможность их самовозбуждения, как высокочастотных элементов с большим коэффициентом усиления, и принимать меры к его устранению.